

2SD892, 2SD892A

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形ダーリントン

低周波増幅用

■ 特長

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高く設計されているので、モータドライブ、プリンタ用ハンマドライブなどに適している： $h_{FE} = 2000 \sim 20000$
- ドライバにはシャント抵抗を省いている。

■ 絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SD892	30	V
	2SD892A	60	
コレクタ・エミッタ電圧	2SD892	25	V
	2SD892A	50	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	0.75	A
コレクタ電流	I_C	0.5	A
コレクタ損失	P_C	400	mW
接合部温度	T_J	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

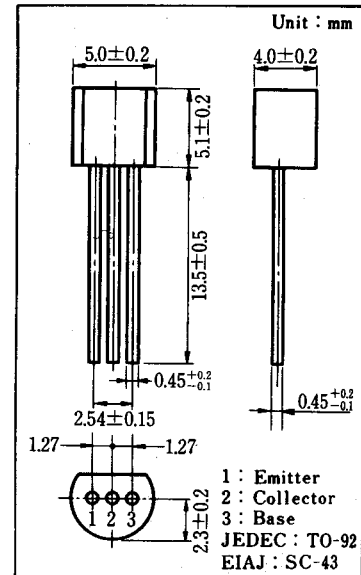
■ 電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 25\text{ V}, I_E = 0$			100	nA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 4\text{ V}, I_C = 0$			100	nA
コレクタ・ベース電圧	2SD892	$I_C = 100\ \mu\text{A}, I_E = 0$	30			V
	2SD892A		60			
コレクタ・エミッタ電圧	2SD892	$I_C = 1\text{ mA}, I_B = 0$	25			V
	2SD892A		50			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 100\ \mu\text{A}, I_C = 0$	5			V
直流電流増幅率	h_{FE}^{*1}	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 500\text{ mA}^{*2}$	2000		20000	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 500\text{ mA}, I_B = 0.5\text{ mA}^{*2}$			2.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 500\text{ mA}, I_B = 0.5\text{ mA}^{*2}$			3	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = -50\text{ mA}, f = 200\text{ MHz}$		150		MHz

*2 パルス測定

*1 h_{FE} ランク分類

ランク	P	Q	R
h_{FE}	2000~5000	4000~10000	8000~20000



内部接続図

